

ROTATION DE TP - 3GEA - 1er semestre Année 2017/2018

# séance	1	2	3	4	5	6	7	8	9
date	13-sept	18-oct	08-nov	14-nov	15-nov	06-déc	13-déc	20-déc	10-janv
No de binome									
1	EC1	ET1	ET4	EC2	SSMT	ET2	EC3		ET3
2	ET1	EC1	ET3		EC2	SSMT	ET2	EC3	ET4
3	ET1		EC1	ET3	ET4	EC2	SSMT	ET2	EC3
4	EC1	ET1	ET2	EC2	ET3	ET4	EC3	SSMT	
5	ET1	EC1	ET2		EC2	ET3	ET4	EC3	SSMT
6	ET1	ET2	EC1		SSMT	EC2	ET3	ET4	EC3
7	EC1	ET1		EC2	ET2	SSMT	EC3	ET3	ET4
8	ET1	EC1	ET3	ET4	EC2		SSMT	EC3	ET2
9		ET1	EC1	ET3	ET4	EC2	ET2	SSMT	EC3
10	EC1	ET1		EC2	ET3	ET4	EC3	ET2	SSMT
11		EC1	ET2	ET1	EC2	ET3	ET4	EC3	SSMT
12	ET2		EC1	ET4	ET1	EC2	SSMT	ET3	EC3
13	EC1	ET2	ET4	EC2	ET1	SSMT	EC3		ET3
14	ET2		EC1	ET1	SSMT	EC2	ET3	ET4	EC3

Electrotechnique et Electronique de puissance (ETEP B. Pascal RC)
(J.F. CAPSAL / B. DUCHARNE)
ET1 : Inductance
ET2 : Mesures de puissance
ET3 : Cellule de commutation
ET4 : Machine à courant continu

Electronique (ENII - G. Ferrié 2eme étage)
(P.J. COTTINET)
EC1 : Amplificateur de type émetteur commun
EC2 : Réalisation d'un amplificateur à transistors
EC3 : L'amplificateur différentiel à transistors

Signaux et Système (MAP - B. Pascal RC)
(E. SELLIN)

SSMT : Analyse temporelle et fréquentielle d'un système